

Rys. 1-1069. SS216

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny epitaksjalny *n-p-n* w obudowie plastikowej, ciężar około 0,1 G

Zastosowanie: technika cyfrowa

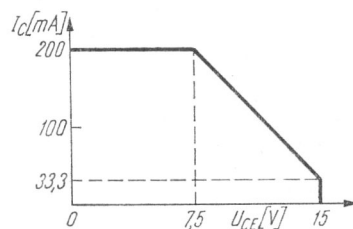
Typy podobne: BSY68/69 (Tel, Ph), BSX80/81 (Tel), 2SC641 (Hit), 2SC715, 2SC716 (San), TIS44 (Tex)

Wartości charakterystyczne¹⁾

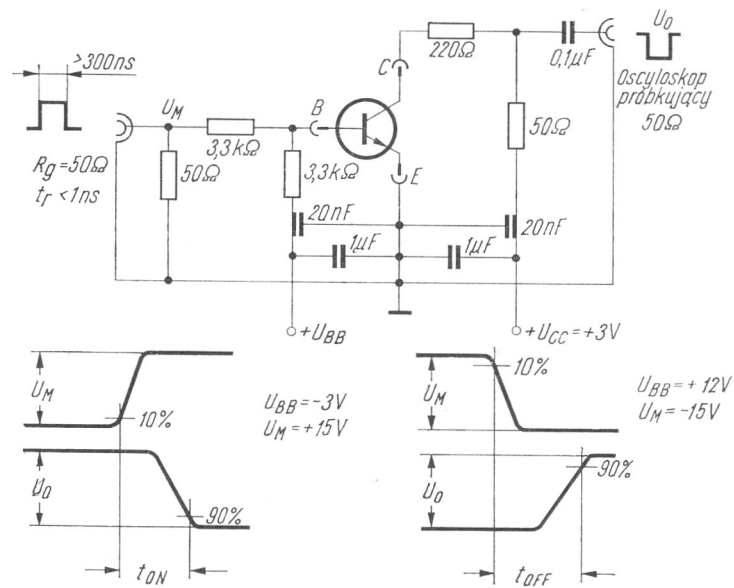
I_{CB0}	7,5	100	nA	przy $U_{CB} = 20$ V
$U_{(BR)CE0}$	15	25	V	przy $I_C = 10$ mA
$U_{(BR)EB0}$	5		V	przy $I_E = 5$ μ A
$U_{CE sat}$	0,2	0,45	V	przy $I_B = 3$ mA, $I_C = 30$ mA
$U_{BE sat}$	0,85		V	przy $I_B = 3$ mA, $I_C = 30$ mA
h_{21E} (A)	18	35		przy $U_{CE} = 0,5$ V, $I_C = 30$ mA
(B)	28	71		
(C)	56	140		
(D)	122	280		
f_T	350		MHz	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 100$ MHz
C_{22b}	2,6		pF	przy $U_{CB} = 10$ V, $I_E = 0$, $f = 2$ MHz
t_{ON}	22		ns	przy $I_C = 10$ mA, $I_{B1} = 3$ mA, $-I_{B2} = 1,5$ mA, $R_L = 270$ Ω
t_{OFF}	280		ns	

Wartości graniczne

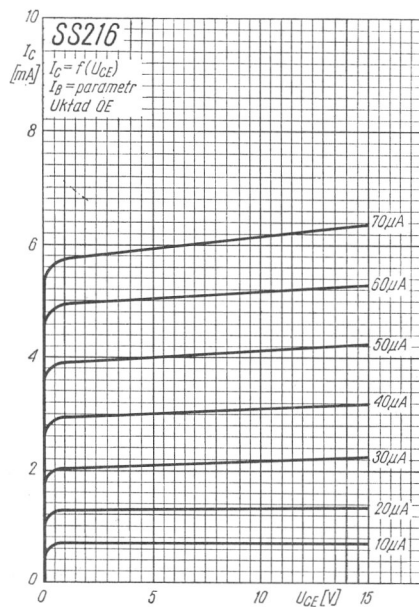
$U_{CB0 max}$	20	V	$I_B max$	20	mA
$U_{CE0 max}$	15	V	$P_{tot max}$	200 ³⁾	mW
$U_{EB0 max}$	5	V	$t_j max$	+125	°C
$I_C max$	100 ²⁾	mA	t_{amb}	-40 ÷ +100	°C
$I_C max$	200	mA	$R_{th j-a}$	≤ 0,5	°C/mW

¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$ (-5°C)²⁾ $t = 0,9$ μ s³⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$ 

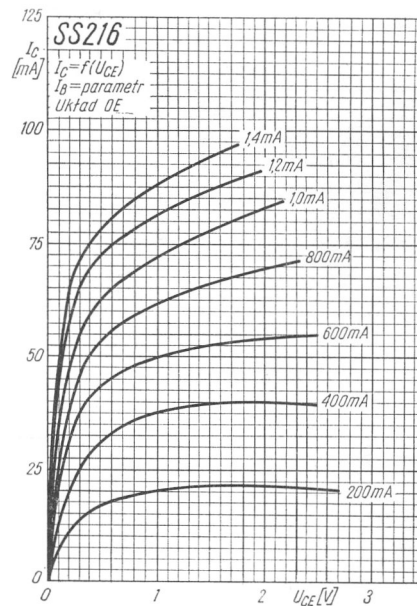
Rys. 1-1070. Dopuszczalny zakres pracy



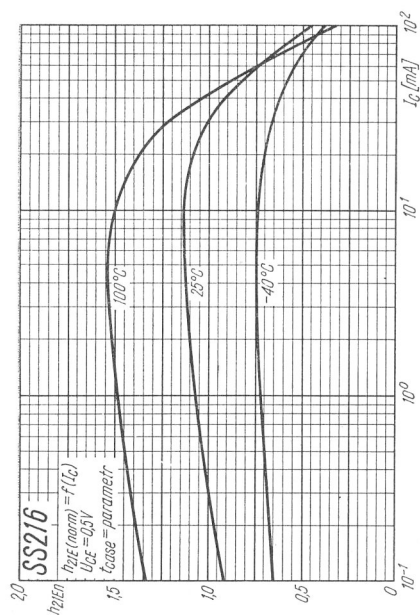
Rys. 1-1071. Układ pomiarowy czasów przełączania



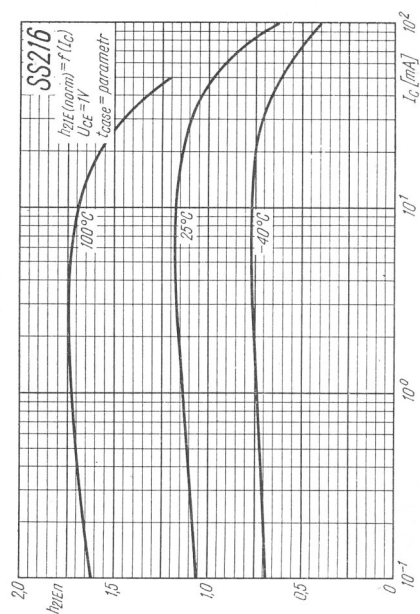
Rys. 1-1072. Charakterystyki wyjściowe



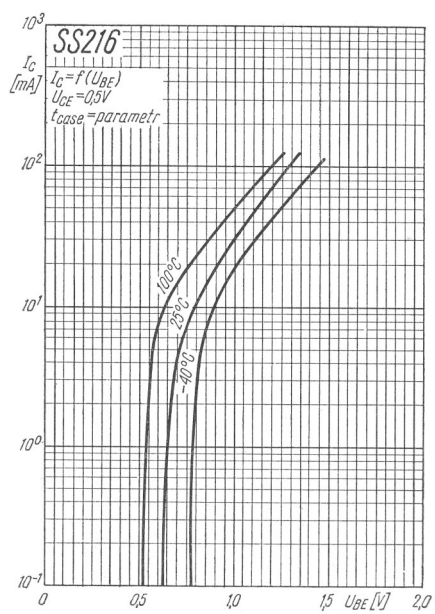
Rys. 1-1073. Charakterystyki wyjściowe



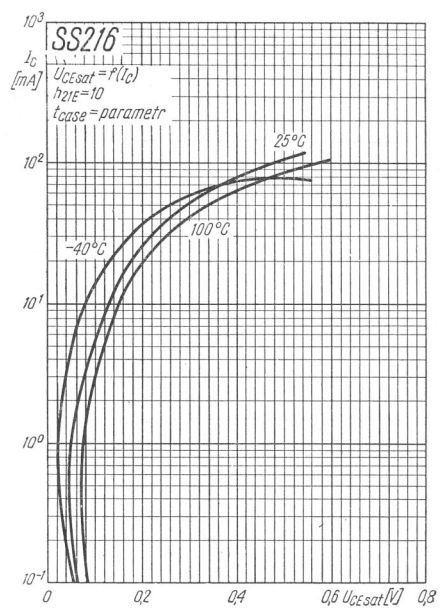
Rys. 1-1074. Zależność normowanego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



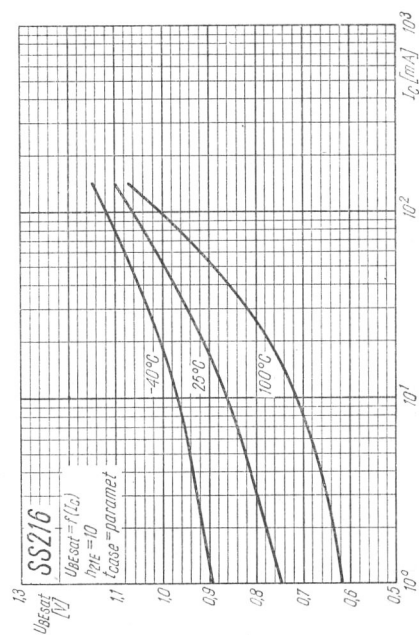
Rys. 1-1075. Zależność normowanego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



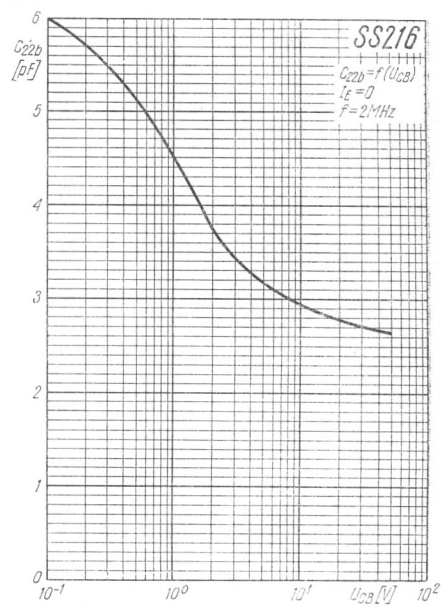
Rys. 1-1076. Charakterystyki sterowania napięciowego



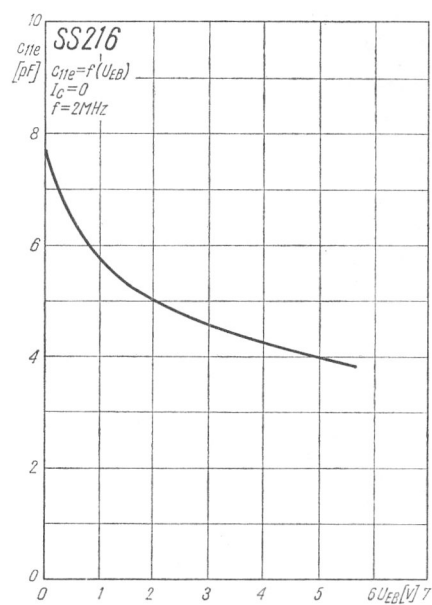
Rys. 1-1077. Zależność napięcia nasycenia kolektora od prądu kolektora



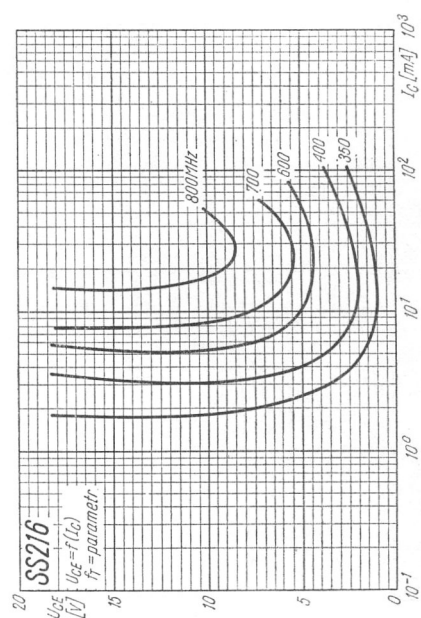
Rys. 1-1078. Zależność napięcia nasycenia bazy od prądu kolektora



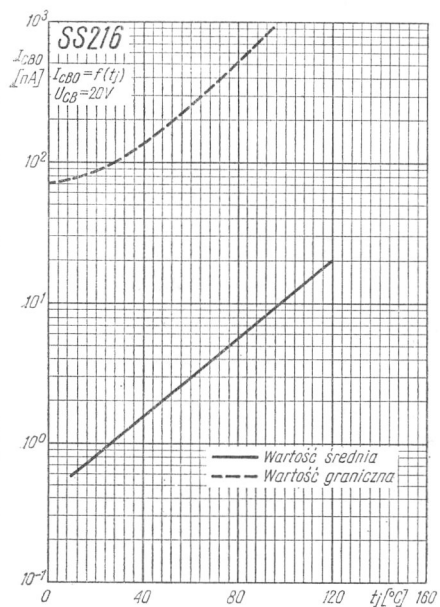
Rys. 1-1079. Zależność pojemności C_{22b} od napięcia



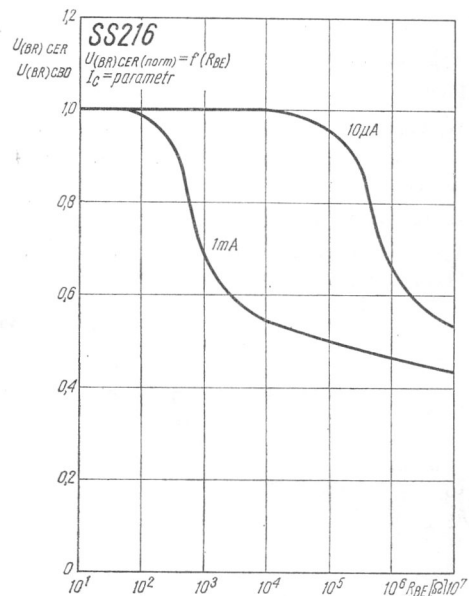
Rys. 1-1080. Zależność pojemności C_{11e} od napięcia



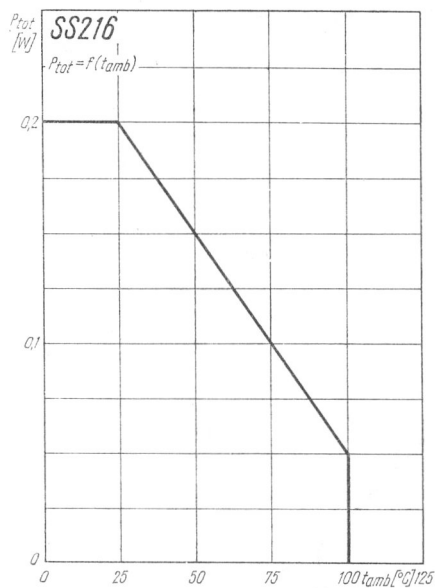
Rys. 1-1081. Zależność napięcia kolektora od prądu kolektora



Rys. 1-1082. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury złącza



Rys. 1-1083. Zależność napięcia przebicia kolektora od rezystancji R_{BE}



Rys. 1-1084. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia